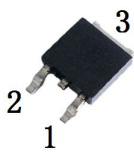


3DD31CT4 型 NPN 硅大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
	P _{tot}	T _A =25℃	1	W
	I _C		3	A
	I _{CM}		5	A
	T _{jm}		150	℃
	T _{stg}		-55~150	℃
直 流 参 数	V _{(BR)CBO}	I _{CB} =1mA	≥100	V
	V _{(BR)CEO}	I _{CE} =1mA	≥100	V
	V _{(BR)EBO}	I _{EB} =1mA	≥5.0	V
	I _{CEO}	V _{CB} =60V	≤50	μA
	I _{EBO}	V _{CE} =5V	≤0.1	mA
	V _{CEsat}	I _C =3A I _B =375mA	≤1.2	V
	h _{FE}	V _{CE} =4V I _C =1A	≥25	
		V _{CE} =4V I _C =3A	10~50	
外 引 线 说 明	<div><p>TO-252</p><p>1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极</p></div>			
	替代型号:MJD31CT4			

筛选:

序号	筛选项目	条 件
1	高温贮存	150° C±2° C， 96h
2	温度循环	-55° C±3° C， 125° C±2° C， 5 次循环
3	功率老炼	老炼条件:TA=25℃, VCE=20V ,IC=50mA , 8h TC=75±5℃
4	常温测试	按本参数页规定
5	外观检验	打标志之后进行

编制:

审核: (测试条件)
(老化条件)

批准:

日期: